

L'ONDE ÉLECTRIQUE

Revue Mensuelle publiée par la Société des Radioélectriciens
avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique

ABONNEMENT D'UN AN	ÉDITIONS CHIRON	Prix du
FRANCE 2500 F	40, Rue de Seine — PARIS (6 ^e)	Numéro :
ÉTRANGER 2800 *	C. C. P. PARIS 53-35	250 francs

Vol. XXXIV

AOUT-SEPTEMBRE 1954

Numéro 329-330

SOMMAIRE

		Pages
La Photoconductivité	A. ROSE	645
Les compteurs de Geiger-Müller (G.M.). Les circuits associés et techniques de comptage	E. PICARD A. BENOIT	652
L'impédance parasite de cathode	M. BERTHAUD	663
Appareil sensible pour la mesure de la résistance parasite de cathode	P. SEVIN	673
Les limites théoriques de la transmission en cas de niveau de bruit élevé, pour différents systèmes de modulation continue et de modulation codée	P. DE JAGER	675
Spectre moyen d'une suite d'impulsions en principe périodiques et identiques mais déplacées et déformées aléatoirement	R. FORTET	683
Les réseaux correcteurs pour servomécanismes à fréquence porteuse	P. BONNET	688
Description d'un dispositif d'enregistrement	P. DESRETOIS A. PAGES	700
Soixantenaire de l'Ecole Supérieure d'Electricité		705
In memoriam : Michel ADAM	P. LIZON	722

Sur la couverture :

Gamme de tubes compteurs GEIGER-MÜLLER fabriqués en série par le Laboratoire Central de Télécommunications sous licence du Commissariat à l'Énergie Atomique.

Les opinions émises dans les articles ou comptes rendus publiés dans L'Onde Electrique n'engagent que leurs auteurs.

SOCIÉTÉ DES RADIOÉLECTRICIENS

FONDATEURS

+ Général FERRÉ, Membre de l'Institut.

+ H. ABRAHAM, Professeur à la Sorbonne.
+ A. BLONDEL, Membre de l'Institut.
P. BENOIT, Directeur à la Cie Générale de T.S.F.
J. CORNU, Chef de bataillon du Génie e. r.

+ A. PÉROT, Professeur à l'Ecole Polytechnique.
+ J. PANAF, Directeur de la Sté des Forces Motrices de la Vienne.
La Société des Ingénieurs Coloniaux.

SOCIÉTÉ DES RADIOÉLECTRICIENS

10, Avenue Pierre-Larousse, Malakoff (Seine)

Tél. ALÉSIA 04-16 — Compte de chèques postaux Paris 697-38

CHANGEMENTS D'ADRESSE : Joindre 20 francs à toute demande

LA PHOTOCONDUCTIVITÉ ⁽¹⁾

PAR

Albert ROSE

R. C. A. Laboratories, Princeton, N. J. (U. S. A.)

Cette communication met en évidence trois idées principales : la première idée est que la théorie de la photoconductivité est extrêmement simple ; le second point établit que les données des expériences sont complexes et paraissent habituellement contredire la théorie simple ; enfin le troisième point montre que la mise en accord de la théorie et de l'expérience est une méthode efficace pour préciser la disposition des niveaux d'énergie dans la « zone interdite » d'un photoconducteur. On traite particulièrement la catégorie des photoconducteurs qui se comportent comme des isolants dans l'obscurité et on a choisi le sulfure de cadmium CdS, sous forme de monocristal, comme type de ces semi-conducteurs.

Avant de discuter ces trois questions, nous décrivons succinctement les phénomènes de photoconductivité dont nous ferons un bref historique.

La photoconductivité, c'est-à-dire l'influence de la lumière sur le nombre des électrons libres dans les solides, a été observée pour la première fois il y a quelque 75 ans, soit près de 20 ans avant l'identification de l'électron libre dans le vide. Un coup d'œil sur l'histoire de ces deux phénomènes, électrons libres dans le vide et électrons libres dans les solides permet d'indiquer la différence frappante qui existe entre eux. Il suffit d'énumérer seulement une partie de la grande variété des tubes à vide, qui contraste avec l'absence presque complète d'appareils formés de solides. En fait, c'est seulement au cours des toutes dernières années qu'il a commencé à apparaître des appareils formés de solides sous une forme utilisable. Il est évident que cette histoire succincte, plus que toute autre chose, résume la différence importante qui existe entre les propriétés des électrons libres dans les solides et celles des électrons libres dans le vide. Les dernières propriétés peuvent facilement être décrites et soumises au calcul, et elles permettent de faire le projet d'un tube avec quelque certitude au sujet du résultat final. Au contraire les premières propriétés ont un caractère exclusivement expérimental. Cela ne signifie pas

que les propriétés des porteurs de charges libres dans les solides soient nécessairement complexes ; cela signifie plutôt que nous devons attendre que les fabricants de solides produisent des échantillons aussi parfaitement simples que les niveaux d'énergie employés par les physiciens pour décrire un solide. Dans le cas des corps relativement isolants, par exemple, le degré de perfection qui est susceptible de conduire à des performances améliorées est bien au-delà de ce que l'on considère comme le fini usuel. La perfection dans une partie sur 10^{12} serait facilement reconnue et elle rendrait possible la création de nouveaux types d'appareils.

Après les observations initiales de photoconductivité de 1875, il a été fait peu d'études de caractère quantitatif avant le travail de base de HILSCH, GULDEN et POHL, vers les années 1920. L'Ecole de Goettingue se proposait d'établir la nature quantique du phénomène de photoconductivité. Cela signifie que les expérimentateurs voulaient montrer qu'un photon unique pouvait produire seulement un électron libre unique dans un solide, comme cela avait été établi pour l'effet photoélectrique externe dans le vide. Pour cette raison, ces auteurs mettaient en évidence ce qu'ils nommaient le photo-effet « primaire », où l'on enregistre dans le circuit extérieur une charge électronique pour chaque photon absorbé par le photoconducteur. En cela, ils ont réussi. Mais le photo-effet « primaire » est seulement un exemple très particulier de photoconductivité. Le caractère particulier du travail de l'Ecole de Goettingue a fait négliger, longtemps, les effets photoconductifs où l'on observe plus qu'une seule charge électronique dans le circuit externe pour chaque photon absorbé. Ils les dénommèrent « courants secondaires » et ils les écartèrent comme ayant peu de valeur scientifique ; cette mise à l'écart dura longtemps, même après que HILSCH lui-même, en 1937, eût reconnu ⁽²⁾ le caractère fondamental des photocourants « secondaires ». En fait, le travail de HILSCH et POHL de 1937 fut suivi, dix ans plus tard, par une seconde étude de POHL et STOCK-

(1) Réunion commune de la Société française de Physique et de la Société des Radioélectriciens, le 12 octobre 1953.

(2) R. HILSCH et R. POHL, « Courants d'électrons photoélectriques stationnaires primaires et secondaires dans les cristaux », *Z. f. Phys.*, t. 108, p. 55, 1937.

MANN ⁽³⁾, exposant à nouveau l'essentiel de l'article de 1937 d'une manière plus simple, parce que l'on n'avait porté que peu d'attention à l'étude de 1937.

Vers 1937, cependant, et certainement vers 1947, on avait obtenu une meilleure connaissance de plusieurs parties de la nature essentielle de la photoconductivité. Les bases de cette théorie nouvelle ont été établies en 1930 par la théorie des bandes dans les solides. La nouvelle théorie a consisté simplement à prendre dans son sens littéral le mot « photoconductivité » : une *variation de la conductivité* produite par la lumière. Quand on considère la photoconductivité comme une *variation de la conductivité*, c'est une question tout à fait secondaire que de savoir si pour chaque photon absorbé, on observe dans le circuit secondaire une charge élec-

tronique, ou $\frac{1}{10}$ de charge électronique, ou 1 000 charges électroniques. Le nombre particulier des charges électroniques produites par un photon absorbé dépend du temps de relaxation de la variation de conduction produite par la lumière et ce nombre varie avec la distance des électrodes et avec la tension appliquée. En résumé on peut écrire d'une manière tout à fait générale :

nombre des charges électroniques produites / nombre des photons absorbés = gain

= G = $\frac{\tau}{T_r}$ (1)

où τ est la durée de vie dans la bande de conduction d'un porteur de charge produit par photo-excitation et T_r le temps de transit entre les électrodes d'un porteur de charge libre. En fonction des quantités observables, la relation (1) devient :

$I = e F G = e F \frac{\tau}{T_r} = e F \frac{V \mu}{L^2}$ (2)

où I est l'intensité du photo-courant observé ; e la charge d'un électron, F le nombre de photo-excitations par seconde, et V, μ, L respectivement la tension appliquée, la mobilité et la distance des électrodes. Il est clair que la quantité physique importante est τ , durée de vie d'un porteur de charges photoexcité dans la bande de conduction⁽⁴⁾. Quand cette durée de vie est grande par rapport au temps de transit des porteurs, on peut observer beaucoup de charges électroniques produites dans le circuit extérieur pour chaque photon absorbé, à condition que le contact au photoconducteur soit ohmique ; cette condition signifie que, à la frontière entre le métal et le semi-conducteur, il existe une réserve de porteurs prêts à pénétrer dans le semi-conducteur quand ils y seront « appelés ». Par exemple si un électron supplémentaire est produit par la lumière, et que cet électron soit transporté vers l'extérieur

jusqu'à l'anode, il laisse derrière lui une charge positive qui « appelle » un autre des électrons du réservoir pour qu'il entre dans le photoconducteur. Ce mouvement des électrons persistera jusqu'à ce que l'une des séries des électrons passant à travers le photoconducteur se combine à nouveau à l'un des centres à partir duquel le photoélectron avait été excité en premier lieu.

Dans le but de l'orientation, la figure 1 indique les performances à attendre d'un photoconducteur

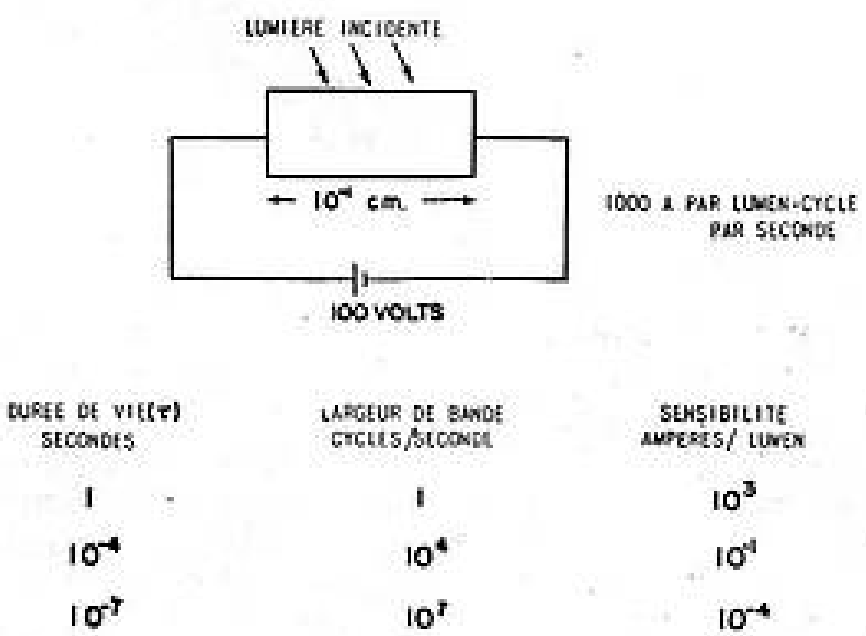


FIG. 1

soumis à une différence de potentiel, appliquée entre deux électrodes écartées

et d'autres rayonnements d'énergie élevée pour moduler la conductivité d'un solide est une variante évidente de l'emploi de la lumière visible. Une dernière méthode, apparemment vulgaire, pour moduler la conductivité de l'espace compris entre deux électrodes est d'employer un moyen mécanique pour y amener des porteurs, par exemple de placer un morceau de cuivre entre ces deux électrodes. Il apparaîtra rapidement que cette méthode n'est pas vulgaire.

Dans le problème général de la commande, on cherche à obtenir la quantité la plus élevée possible à la sortie pour une quantité aussi faible que possible à l'entrée. Suivant ces règles, les méthodes différentes de modulation de la conductivité d'un solide peuvent être classées suivant l'énergie nécessaire pour produire un porteur supplémentaire. Dans la photoconductivité, par exemple, en employant la lumière visible, il faut deux ou trois électrons-volts pour créer un porteur libre. L'emploi de la chaleur est une méthode particulièrement coûteuse, car plusieurs centaines d'électrons-volts sont nécessaires pour produire un porteur dans les matériaux où il

transportés par des oscillations mécaniques, par exemple par le déplacement d'un fragment d'un métal; cette énergie est de l'ordre de quelques millivolts même quand la période de mouvement atteint un mégacycle par seconde.

Revenant à la photoconductivité, le caractère physique essentiel de ce phénomène est contenu dans la notion relative à τ , durée de vie d'un porteur de charges. On pense tout d'abord qu'il est possible d'observer cette durée de vie, qu'on peut identifier avec la vitesse de réponse d'un photoconducteur, définie comme étant le temps nécessaire pour que la photoconductivité décroisse jusqu'à la moitié de sa valeur après que l'on a supprimé la lumière excitatrice. Quand on procède à une vérification même sommaire, des performances des cristaux de CdS sous faible intensité lumineuse, ou des propriétés des matériaux relativement isolants employés comme cibles photoconductrices dans les tubes de télévision du type Vidicon, on voit facilement que la vitesse de réponse observée atteint jusqu'à 10^4 à 10^5 fois la durée de vie nécessaire pour satisfaire à la relation (1). On doit signaler particulièrement que l'équation (1) a un caractère général et qu'elle ne se rapporte pas à un type particulier de photoconducteur. Elle s'applique aux semi-conducteurs uniformes, aux jonctions P-N, aux jonctions N-P-N et même aux cellules photoélectriques dans le vide. Il n'y a qu'un cas d'exception : le phénomène où les photoélectrons sont multipliés par un processus

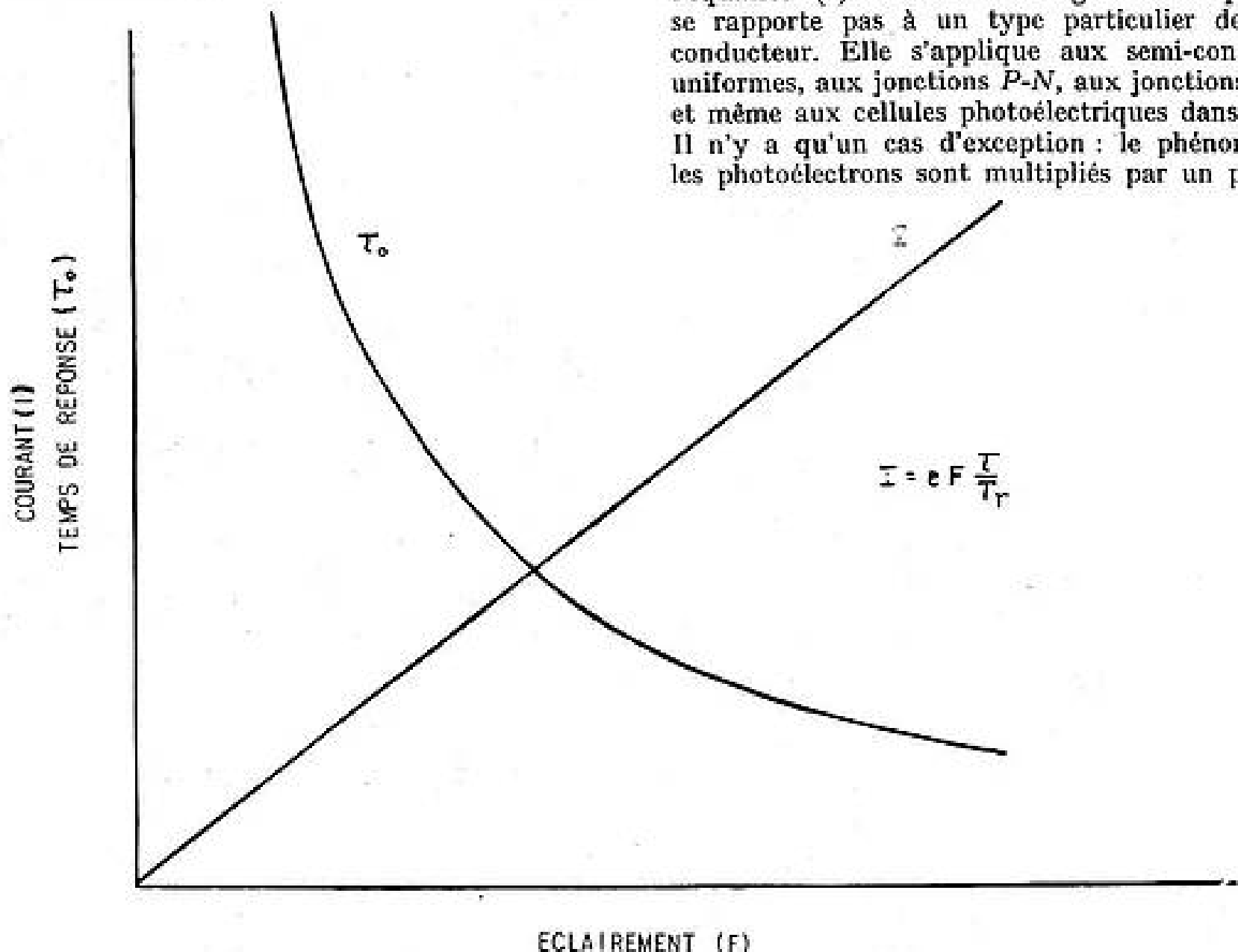
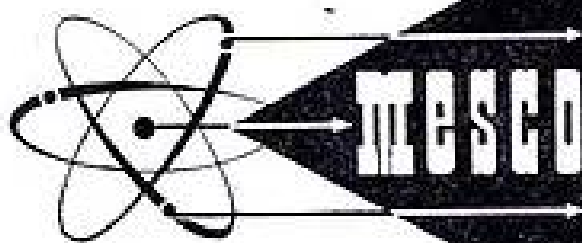


FIG. 1

existe des intervalles interdits entre $\frac{1}{2}$ V et 1 V. D'autre part, l'injection de porteurs de charges, comme dans le transistor, est une méthode particulièrement économique, nécessitant seulement quelques centièmes d'électron-volt pour produire un porteur de charges. Finalement, on peut calculer l'énergie pour un porteur quand les porteurs sont

d'avalanche ou d'ionisation interne, qui se produit près de l'intensité du champ disruptif. La plus grande partie des expériences de photoconductivité a été faite sous des champs d'intensité suffisamment faible pour éviter la production d'avalanches d'électrons.

Ce désaccord extraordinaire entre la vitesse de



réponse observée et la durée de vie déduite de l'équation (1) nous a conduit à distinguer entre ces deux quantités, de sorte que, pour les intensités d'excitation faibles la vitesse de réponse (τ_0) est beaucoup plus grande par l'effet des électrons des trappes superficielles que la durée de vie d'un porteur libre (1). Pour les intensités d'excitation élevées (ou pour des courants noirs intenses dans les semi-conducteurs) quand le nombre des porteurs libres dépasse le nombre des porteurs retenus dans les trappes superficielles, la vitesse de réponse observée approche de très près la durée de vie d'un porteur libre.

Le désaccord entre ces quantités durée de vie d'un porteur de charges et vitesse de réponse observée ne constitue par le seul écart entre la théorie et l'expérience. Un second désaccord apparaît dans les cristax de CdS où le photocourant augmente à peu près linéairement avec l'intensité lumineuse alors que la vitesse de réponse observée décroît quand l'intensité lumineuse croît. On déduit immédiatement de l'équation (2) que si le photocourant I est proportionnel à l'intensité lumineuse F , la durée de vie d'un porteur de charges libres doit être constante ; ce que l'on désire est un modèle de photoconducteur qui donne une durée de vie indépendante de l'intensité lumineuse et, simultanément une vitesse de réponse observée décroissant en même temps que l'intensité lumineuse. En résumé on désire un modèle qui rende compte des deux résultats expérimentaux suivants du premier ordre sur les cristaux de CdS.

$$I \sim F \quad (3)$$

$$\tau_0 \sim \frac{1}{F} \quad (4)$$

ces résultats sont indiqués schématiquement figure 2.

Le but de l'étude qui suit est de montrer que, pour rendre compte des deux résultats des expériences du premier ordre indiqués par les équations (3) et (4), il faut qu'il existe dans la région interdite des trappes réparties en énergie d'une manière continue. En conséquence il ne serait pas d'une grande importance de montrer que l'hypothèse d'une répartition continue des trappes rend compte des relations (3) et (4). Une distribution de trappes continue forme un modèle très flexible et très souple susceptible d'expliquer une grande variété de phénomènes. Ce qui est important dans ce qui suit est que tout modèle que ne comprend pas une distribution continue des trappes ne permet pas de rendre compte des résultats expérimentaux définis par les équations (3) et (4). La méthode appliquée dans la suite consiste à prendre comme point de départ les modèles les plus simples, à comparer leurs propriétés à celles qu'expriment les équations (3) et (4) et enfin à augmenter la complexité du modèle seulement quand cela est *logiquement* nécessaire.

Le modèle le plus simple est celui de la figure 3. Ce modèle comprend une bande pleine et une bande de conduction séparées par une bande interdite où

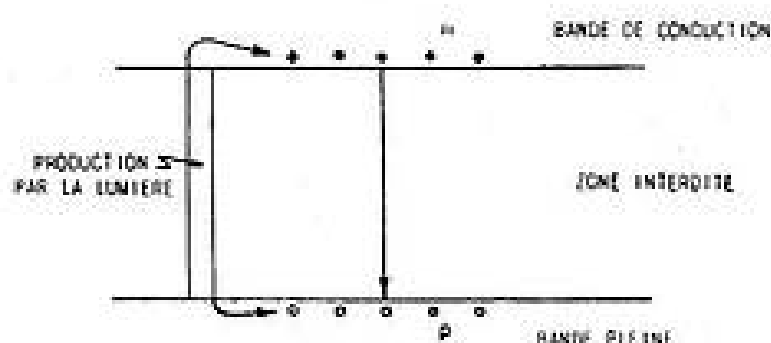
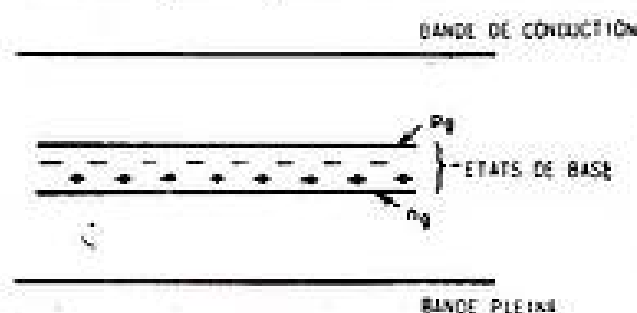


FIG. 3

il n'y a aucun état électronique. Sous l'effet de l'excitation par la lumière, des électrons libres et des trous libres sont créés en proportions égales. De plus les *concentrations en régime permanent* des électrons et des trous doivent être égales, puisqu'il n'y a aucun état électronique dans la zone interdite. Pour la même raison les électrons libres se recombinaient directement aux trous libres. Ce modèle conduit aux relations familières de recombinaison bimoléculaire, dans lesquelles la concentration des porteurs de charges, en régime permanent, est proportionnelle à la racine carrée de l'intensité de la lumière excitatrice. Ce résultat contredit l'équation (3) qui nécessite une concentration des porteurs croissant suivant une fonction linéaire de l'intensité lumineuse. Une seconde contradiction provient du fait que, dans ce modèle, la durée de vie d'un porteur libre et le temps de réponse du photoconducteur sont des paramètres identiques. On déduit des équations (3) et (4) que : la durée de vie est une constante, indépendante de l'intensité lumineuse, et que le temps de réponse décroît quand l'intensité lumineuse croît. Enfin il convient de noter que la recombinaison directe des porteurs libres est un phénomène si improbable que les durées de vie qui en résultent pour les porteurs dépasseraient de beaucoup celles que l'on observe dans les expériences.

La première complication introduite dans le modèle est indiquée figure 4. Ici on a inséré dans



Le nouveau GÉNÉRATEUR d'IMPULSIONS

TYPE
458 A



- Impulsions de 0,5 à 10.000 μ s.
Temps de montée 0,05 μ s
Variation continue de la largeur
- Fréquence de résonance 5 à 50.000 c/s.
- Tensions de sorties symétriques de 0,05 à 50 volts.
- Prédéclencheur inclus.
- Lecture directe de la tension et de la largeur de l'impulsion.



RIBET-DESJARDINS

13, RUE PÉRIER, MONTROUGE (SEINE) ALÉ. 24-40

NOTICE
TECHNIQUE
ET DÉMONSTRATION
SUR DEMANDE

Agent exclusif pour la Belgique : UNIC RADIO BELGE, 51, quai Bonaparte, LIÈGE

ACTA

Les micromoteurs SAPMI

NOTICE
SUR
DEMANDE

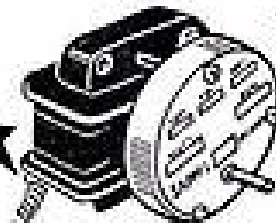
COLLABORATEURS
INFATIGABLES
ET PRÉCIS

DE TOUTE ENTREPRISE
UTILISANT DES APPAREILS
ÉLECTRIQUES



TYPE 300
ASYNCHRONE
de 10 Tours/m
à 1 T. en 30 m

PUISSANCE
ABSORBÉE : 18 WATTS
Couple disponible à 1 T/m
30 kg/CENTIMÈTRE



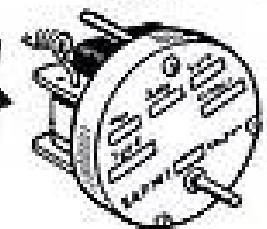
TYPE 350
ASYNCHRONE
de 2.500 T/m
à 2 Tours/min

PUISSANCE
ABSORBÉE : 18 WATTS
Couple disponible à 2 T/m
7 kg/CENTIMÈTRE



TYPE 500
ASYNCHRONE
de 2.300 T/m
à 1 T/30 min

PUISSANCE
ABSORBÉE : 6 WATTS
Couple disponible à 1 T/m
5 kg/CENTIMÈTRE



TYPE 700
ASYNCHRONE
SYNCHRONE
de 750 T/min
à 1 T/8 jours

PUISSANCE
ABSORBÉE : 6 WATTS
ASYNCHRONE couple 1 T/m
8 kg/CENTIMÈTRE
SYNCHRONE couple 1 T/m
2,5 kg/CENTIMÈTRE

SAPMI

MICROMOTOR

VALENCE S/RHONE 18, R. J. J. ROUSSEAU
TÉL. 37-17 37-18

Constante	Constante
Nombre des électrons libres	Intensité de la lumière
$\sim \frac{1}{F}$	

C'est justement la relation expérimentale exprimée par l'équation (4).

Nous pouvons maintenant conclure que le modèle de la figure 6, qui a une distribution continue d'états discrets, donne les deux relations (3) et (4) fournies par l'expérience, qui ne sont données par aucun modèle plus simple. Ce raisonnement n'exclut pas la possibilité d'établir encore des modèles plus complexes que celui de la figure 6, qui satisfassent aux équations (3) et (4). Ce raisonnement définit la limite la plus faible de la complexité nécessaire pour satisfaire aux relations expérimentales.

Le raisonnement présent a été établi pour montrer que la photoconductivité est un outil puissant qui permet d'obtenir des informations précises au sujet de la structure des niveaux d'énergie dans la zone interdite. Ce sont les résultats expérimentaux exprimés par les deux équations simples (3) et (4) qui ont conduit logiquement au besoin d'une distribution continue d'états discrets. D'autre part il est évident que cette distribution continue d'états discrets est rencontrée dans les courbes de luminescence des matériaux luminescents ⁽¹⁾ et dans les courbes de conductivité-luminescence pour ZnS ⁽²⁾ et CdS ⁽³⁾; ainsi, nous avons montré d'une manière simple comment ce continuum d'états discrets rend compte de la règle empirique de MEYER ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ R. H. BUNE, « Luminescence and Trapping in Zinc Sulphide Phosphors with and without Copper Activator » (Luminescence et action des trappes d'électrons dans les matériaux luminescent de sulfure de zinc, avec ou sans activateur de cuivre), *Phys. Rev.*, t. 80, p. 665, 1950.

⁽²⁾ R. H. BUNE, « A Comparative Study of Photoconductivity and Luminescence » (Etude Comparative de la photoconductivité et de la luminescence), *Phys. Rev.*, t. 80, p. 393, 1951.

⁽³⁾ Résultats non publiés de R. H. BUNE et de GARLICH.

⁽⁴⁾ I. BROSER, « The significance of Meyer's rule » (Signification de la règle de Meyer), *Réunion de la Physical Society*, Innsbruck, sept. 1953.

⁽⁵⁾ A. ROSE, « An Outline of some Photoconductive Processes » (Principes de quelques processus de Photoconductivité) *R.C.A. Review*, t. XII, p. 362, 1952.

REMARQUES ET CONCLUSIONS

La discussion actuelle s'applique principalement aux photoconducteurs qui sont relativement isolants quand ils sont soumis à une excitation de niveau faible ou intermédiaire. Aux niveaux d'excitation très élevés, le nombre des porteurs libres dépasse le nombre des électrons retenus dans les trappes superficielles et on trouve les résultats simples de l'équation (1). De plus il est possible d'aller plus loin dans le calcul de la section transversale de capture des états fondamentaux pour les électrons libres. Cette section transversale de capture dans le sulfure de cadmium est d'environ 10^{-22} cm², c'est-à-dire qu'elle est inférieure aux dimensions atomiques de 7 puissances de 10. C'est cette faible étendue de la section de capture qui rend compte de la grande sensibilité du sulfure de cadmium et des autres photoconducteurs sensibles. Jusqu'ici il n'a pas encore été établi de description théorique satisfaisante du processus de capture, sauf quand les sections transversales sont très faibles. Il y a des raisons valables de penser que les sections transversales atteignent 10^{-12} cm² pour les centres de capture chargés. C'est pour les sections très faibles qu'une explication est nécessaire.

La discussion présente a mis en évidence les cas où la relation entre le courant et l'éclairement est linéaire et ceux où elle ne l'est pas. Au point de vue expérimental, on rencontre assez fréquemment des exposants compris entre 0,6 et 1,0. Une publication précédente ⁽⁵⁾ a mis en évidence la distribution des trappes qui est la conséquence de ces exposants. Il y a également des exemples de photoconducteurs où il existe une relation de degré supérieur au premier entre le photocourant et l'intensité de la lumière incidente. Ce problème a un intérêt particulier parce qu'il entraîne des complications non encore discutées dans cette étude. C'est-à-dire que les états discrets de la zone interdite qui sont considérés ici avaient tous le même caractère ou la même section transversale pour les porteurs libres. Pour rendre compte d'une relation de degré supérieur au premier, il apparaît qu'il faut introduire au moins deux catégories d'états fondamentaux caractérisés par des sections transversales de capture différentes pour les porteurs de charges libres.

LES COMPTEURS DE GEIGER-MÜLLER (GM)

LES CIRCUITS ASSOCIÉS ET TECHNIQUES DE COMPTAGE

PAR

A. BENOIT et E. PICARD

*Commissariat à l'Energie Atomique
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay*

I. — INTRODUCTION.

Avec la place de plus en plus importante prise par les méthodes de mesure et de contrôle utilisant des radio-isotopes, on constate actuellement une certaine stabilisation dans la technique des détecteurs de particules. Parmi ceux-ci les compteurs de Geiger-Müller offrent le très grand avantage de la simplicité et de la stabilité sur les autres types de détecteurs connus. C'est le but de cet article, de passer en revue, d'un point de vue pratique les différents problèmes qui sont posés par l'emploi des compteurs de Geiger-Müller et de montrer comment ils interviennent dans le choix de l'appareillage.

On peut séparer l'utilisation des compteurs *GM* en deux principaux groupes :

1° L'emploi des compteurs *GM* par les physiciens nucléaires qui utilisent plus particulièrement les caractéristiques de définition en temps (coïncidence de temps entre deux ou plusieurs phénomènes). Dans ce domaine, les compteurs *GM* sont maintenant concurrencés par les détecteurs à scintillations utilisant des photomultiplicateurs, néanmoins ils sont encore très utilisés dans les recherches sur les rayons cosmiques.

2° Dans presque toutes les applications de radio-isotopes on est amené à compter le nombre de particules émises par les matières radio-actives, aussi l'emploi des compteurs *GM* dans ce domaine s'accroît de jour en jour parallèlement au développement des radio-isotopes. C'est dans ces diverses applications que nous préciserons l'emploi de ce type de détecteur de particules.

II. — FONCTIONNEMENT DES COMPTEURS G M

Les compteurs de Geiger-Müller comportent essentiellement deux électrodes cylindriques coaxiales, disposées dans une enceinte gazeuse. Le remplissage de cette enceinte, variable suivant les types de compteurs, est constitué d'un mélange de deux ou

trois gaz différents ; la pression totale est de l'ordre de quelques centaines de mm Hg.

Lorsqu'une différence de potentiel convenable est appliquée entre les deux électrodes, la libération d'une seule paire d'ions dans l'espace interélectrode provoque dans le gaz un processus de multiplication, aboutissant à une décharge de Townsend. Une particule ionisante peut, dans ces conditions, être détectée lors de son passage dans le compteur en recueillant aux bornes d'une résistance *R* l'impulsion de tension engendrée par la décharge (fig. 1). Le

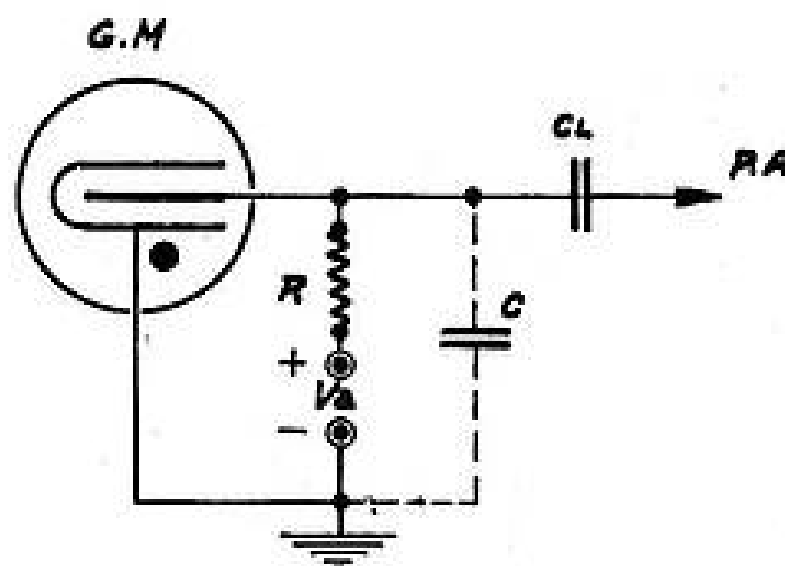


FIG. 1. — Montage électrique d'un compteur :

GM : Compteur Geiger-Müller.
R : Résistance de charge.
V_a : Haute tension d'alimentation.
C : Capacité parasite.
C_L : Capacité de liaison.
P.A. : Pré-amplificateur.

nombre de charge ainsi recueillies est généralement beaucoup plus élevé que celui créé initialement par la particule incidente. Le compteur se comporte comme un amplificateur de charges dont le coefficient d'amplification (10^4 à 10^{10}) dépend de la géométrie des électrodes, de la tension appliquée et du remplissage du tube.

Si l'on trace la courbe représentant le nombre *N* de décharges par unité de temps en fonction de la tension *V_a*, on obtient, pour des valeurs de *V_a*

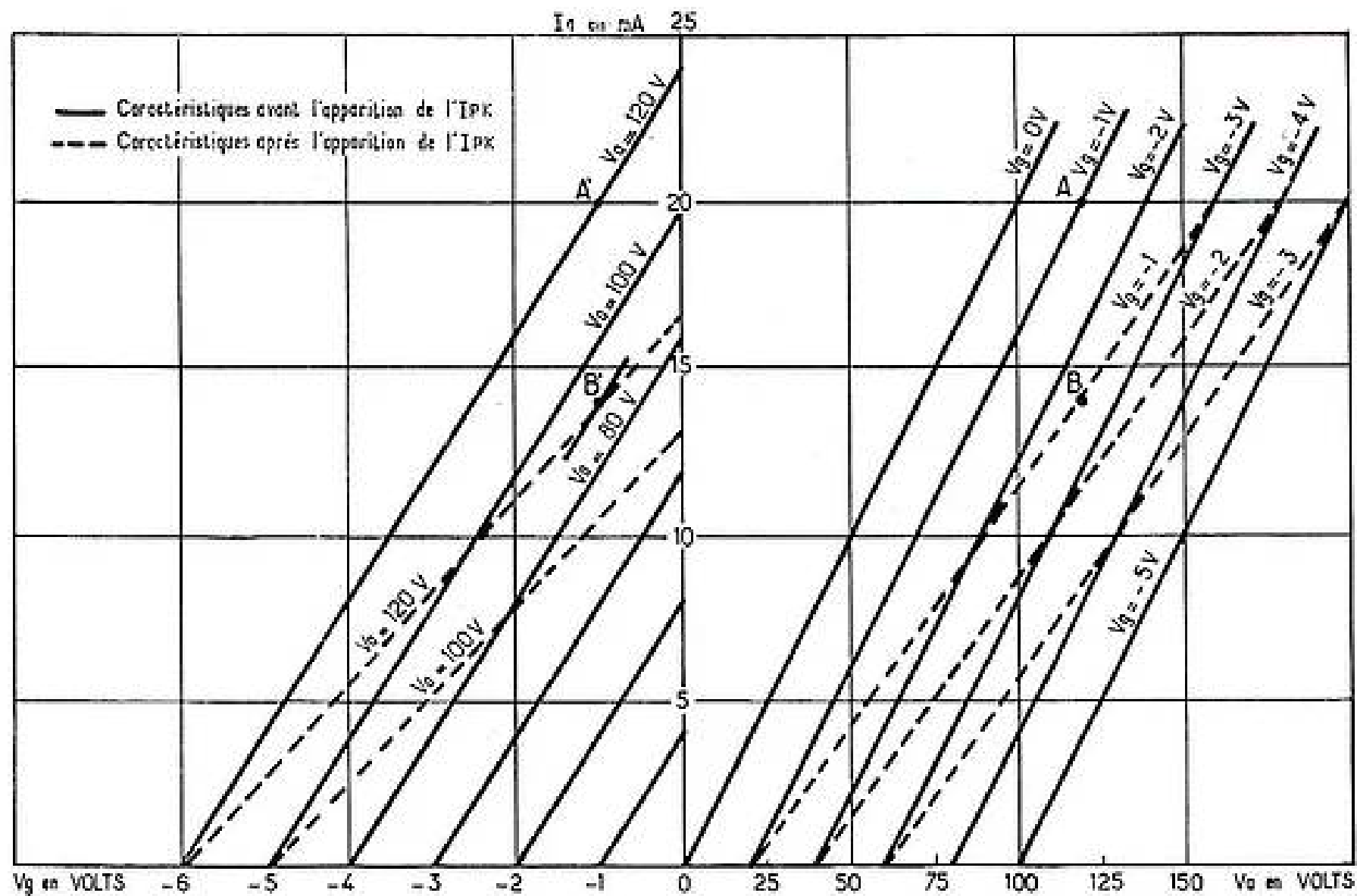


FIG. 3

téristique en trait plein, avec une pente de 4 mA/V. Si le tube en question fait partie d'un amplificateur à large bande, la courbe de réponse de celui-ci se déformera progressivement au cours de l'apparition du défaut.

Si le tube est employé en impulsions, celles-ci subiront une déformation ; en particulier, si le tube doit transmettre des impulsions carrées, celles-ci présenteront à la sortie un dépassement balistique (fig. 3).



FIG. 3

A mesure que le condensateur de découplage se charge, le tube se polarise et l'émission semble décroître avec le temps suivant une loi exponentielle dont la constante de temps est comprise entre 0,1 et 1 μ s.

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPÉDANCE PARASITE DE CATHODE.

Nous avons donné tout à l'heure un schéma simple de l'Ipk pour expliquer les perturbations qu'elle apporte au fonctionnement des tubes. En fait, les choses sont moins simples que cela, car la

résistance parasite de cathode n'est pas une résistance ohmique.

I. — Réalité physique de l'Ipk.

C'est pourtant une résistance bien physiquement réelle, et la preuve la plus simple de cette réalité physique est qu'elle provoque un effet Joule qui peut amener, pour des courants forts et pour les valeurs élevées d'Ipk, un échauffement de la cathode, suffisamment visible pour que, à l'époque héroïque de l'Ipk, certains auteurs aient essayé de mesurer par ce moyen la résistance parasite.

II. — Variation de la valeur de l'Ipk.

La valeur de cette résistance est variable et dépend des conditions de mesure.

1° Influence du courant débité par la cathode pendant la mesure.

La figure 4 représente une courbe, relevée sur une 6AK5, donnant la valeur de la résistance parasite en fonction du courant cathodique : la résistance croît quand le courant augmente ; ce phénomène est général. Il y a toutefois une condition : celle de rester dans certaines limites de courant, car si l'on provoque par effet Joule un échauffement de la cathode, le phénomène se modifie.

2° Influence de la température de la cathode au moment de la mesure.

